

Rys. 1-860. SF126

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: RFT

Wykonanie: tranzystor krzemowy epitaksjalno-planarny *n-p-n* w obudowie metalowej, kolektor połączony z obudową, ciężar około 1 G

Zastosowanie: wzmacniacze szerokopasmowe i średnioszybkie przełączniki

Typy podobne: BSY24, BSY81, BSY82 (ITT), BSY51/52 (Ph, Se, ITT)

Wartości charakterystyczne¹⁾

	min	typ	max			
I_{CBO}			100	nA	przy $U_{CBO} = 33$ V	
I_{EBO}			1	μ A	przy $U_{EB} = 7$ V	
$U_{(BR)CEO}$	20			V	przy $I_C = 50$ mA	
U_{CEsat}		0,2	0,5	V	przy $I_C = 150$ mA, $I_B = 15$ mA	
h_{21E} (A)	18		35	}	przy $U_{CE} = 2$ V, $I_C = 50$ mA	
(B)	28		71			
(C)	56		140			
(D)	112		280			
(E)	224		560			
(F)	450		1120			
f_T	60	100		MHz	przy $U_{CE} = 10$ V, $I_C = 10$ mA, $f = 15$ MHz	
F		4,5		dB	przy $U_{CE} = 6$ V, $I_C = 0,2$ mA, $f = 1$ kHz, $R_g = 500 \Omega$ $\Delta f = 1$ kHz	
h_{11e}		1,25		k Ω	}	przy $U_{CE} = 6$ V, $I_C = 2$ mA, $f = 1$ kHz
h_{12e}		4,1		10^{-4}		
h_{21e}		100				
h_{22e}		27		μ S		
g_{11e}		3,8		mS		
b_{11e}		177		pF		
g_{22e}		6,4		mS	}	przy $U_{CE} = 6$ V, $I_C = 2$ mA, $f = 5$ MHz
b_{22e}		29		pF		
$\frac{ h_{12b} }{\omega}$	150	300	500	ps		
t_r			0,55	μ s	przy $m = 1$	
t_s			1,3	μ s	przy $m = 3$	

¹⁾ $t_{amb} = 25^\circ\text{C} (-5^\circ\text{C})$

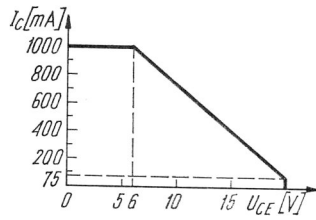
SF126

Wartości graniczne

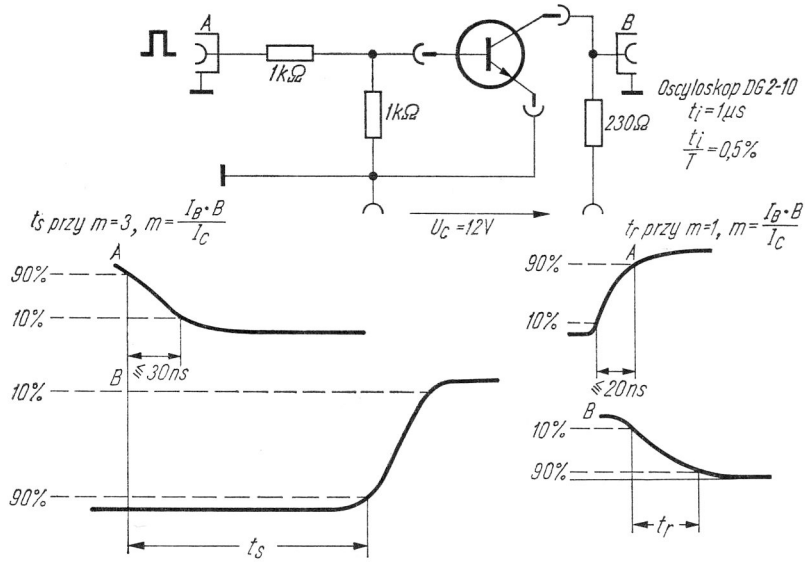
$U_{CB0 \text{ max}}$	33	V	$P_{\text{tot max}}$	600 ²⁾	mW
$U_{CE0 \text{ max}}$	20	V	$P_{\text{tot max}}$	2,5 ³⁾	W
$U_{EB0 \text{ max}}$	7	V	$t_{j \text{ max}}$	+175	°C
$I_C \text{ max}$	500	mA	t_{amb}	-40 ÷ +125	°C
$I_C \text{ max}$	1	A	$R_{\text{thj-a}}$	≤ 0,25	°C/mW
$I_B \text{ max}$	250	mA	$R_{\text{thj-c}}$	≤ 0,06	°C/mW

2) $t_{\text{amb}} = 25^\circ\text{C}$

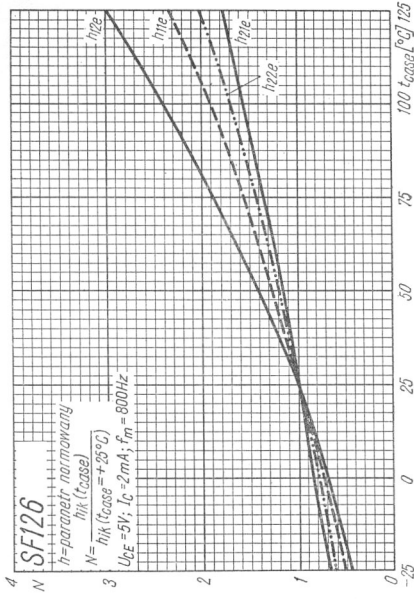
3) $t_{\text{case}} = 25^\circ\text{C}$



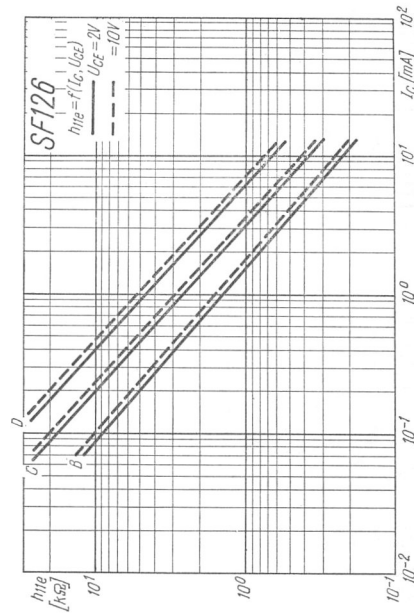
Rys. 1-861. Dopuszczalny zakres pracy



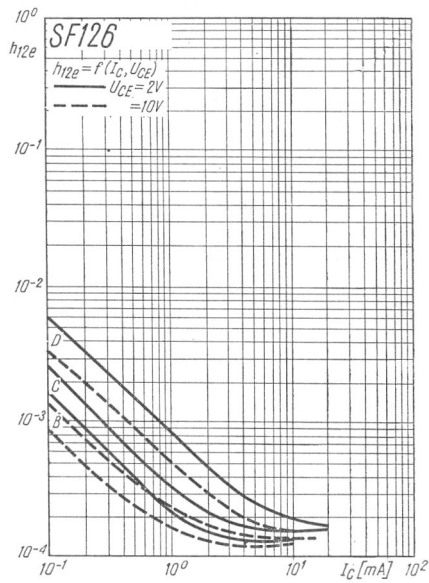
Rys. 1-862. Układ pomiarowy czasów przełączania



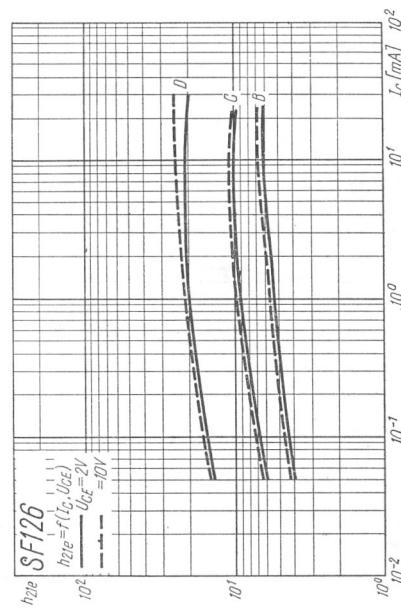
Rys. 1-863. Zależność parametrów h od temperatury obudowy



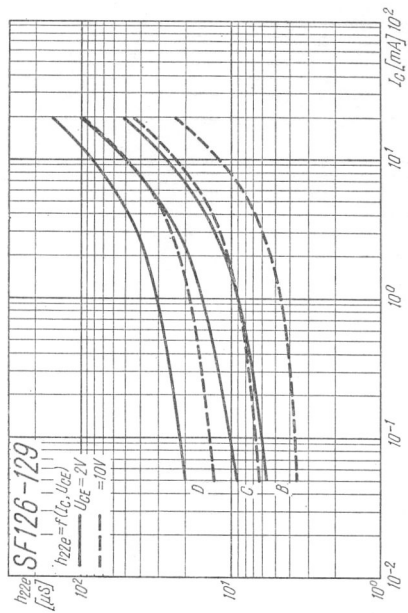
Rys. 1-864. Zależność impedancji wejściowej od prądu kolektora



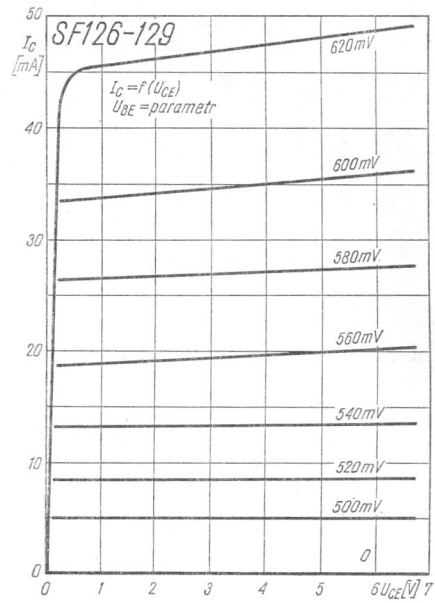
Rys. 1-865. Zależność współczynnika sprzężenia zwrotnego od prądu kolektora



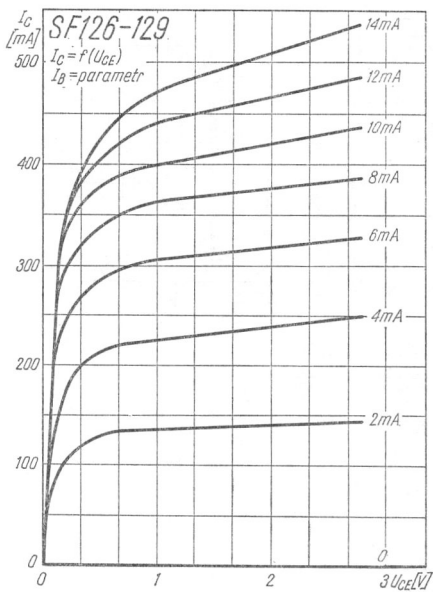
Rys. 1-866. Zależność współczynnika wzmocnienia prądowego h_{21e} od prądu kolektora



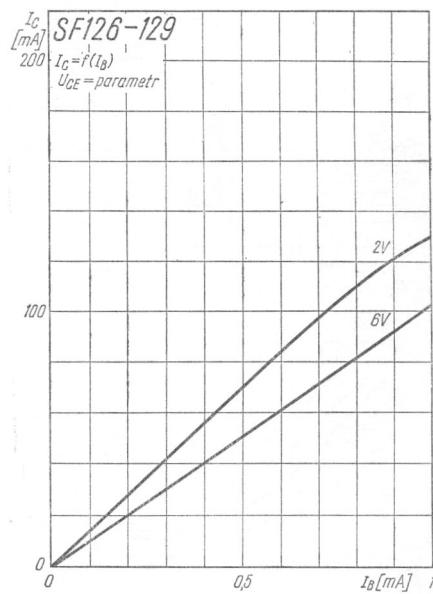
Rys. 1-867. Zależność admitancji wyjściowej od prądu kolektora



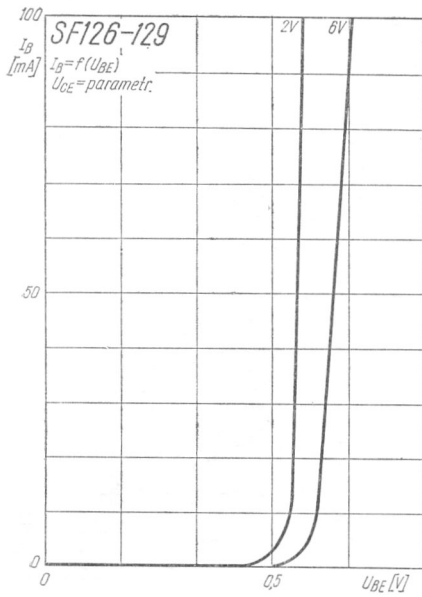
Rys. 1-868. Charakterystyki wyjściowe



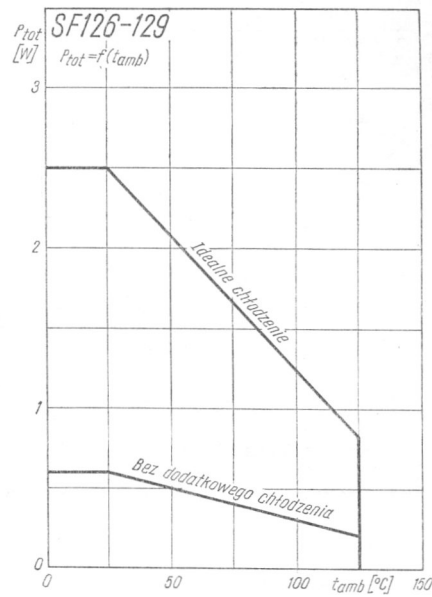
Rys. 1-869. Charakterystyki wyjściowe



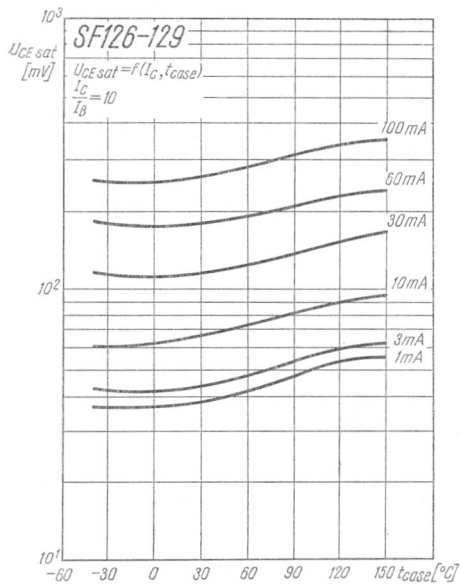
Rys. 1-870. Charakterystyki sterowania prądowego



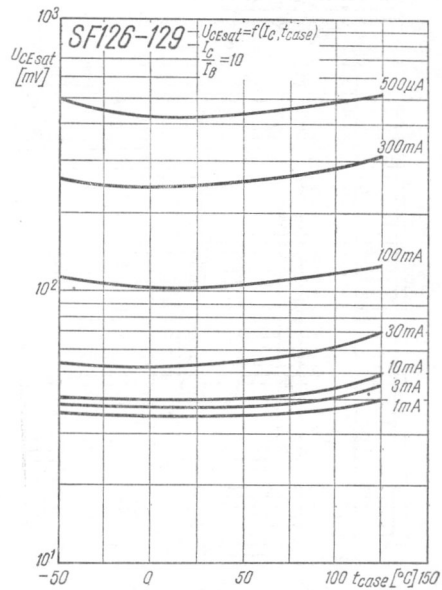
Rys. 1-871. Charakterystyki wejściowe



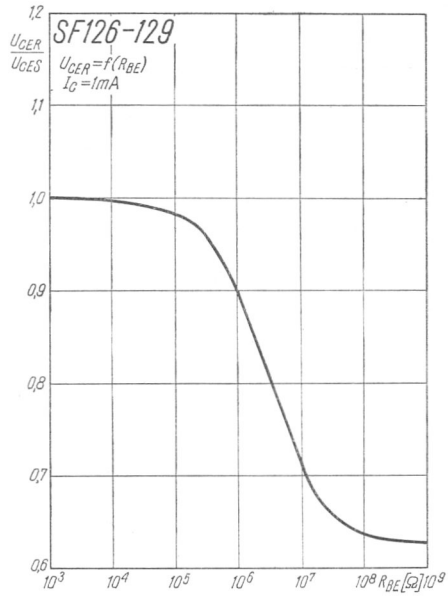
Rys. 1-872. Zależność mocy strat od temperatury otoczenia



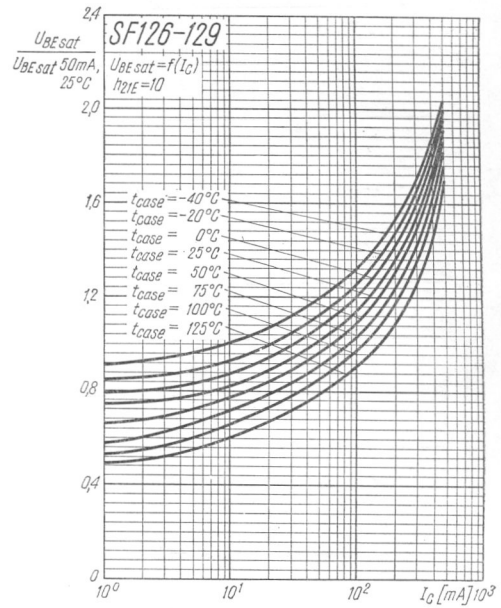
Rys. 1-873. Zależność napięcia nasycenia kolektora od temperatury obudowy



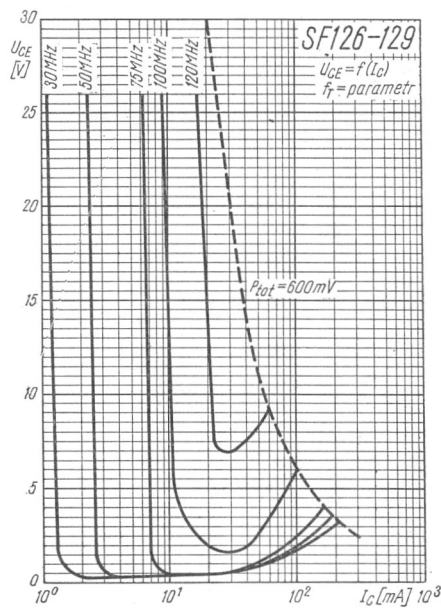
Rys. 1-874. Zależność napięcia nasycenia kolektora od temperatury obudowy



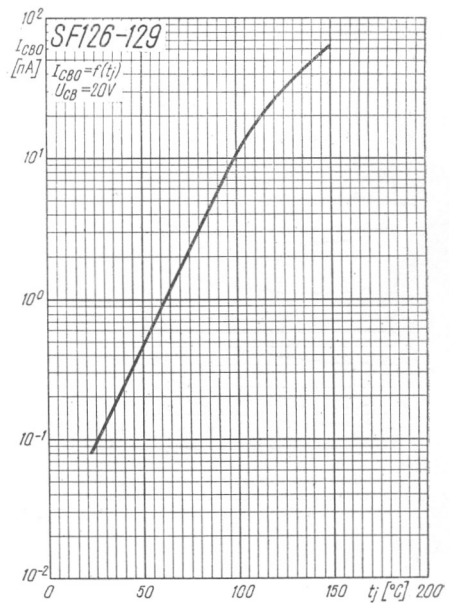
Rys. 1-875. Zależność napięcia kolektora od rezystancji R_{BE}



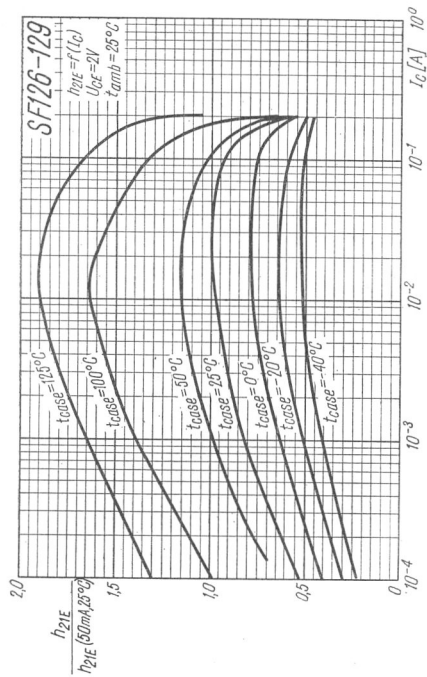
Rys. 1-876. Zależność napięcia nasycenia bazy od prądu kolektora



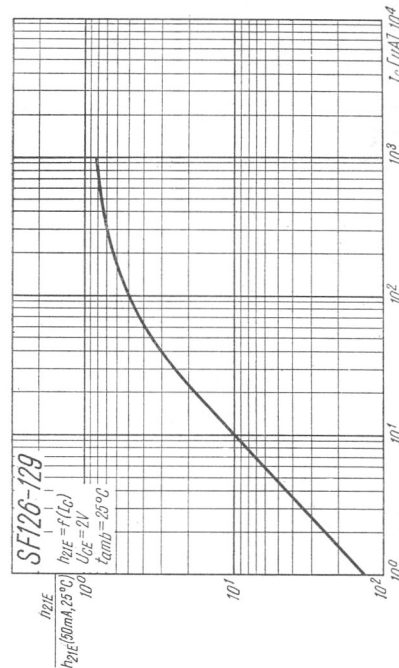
Rys. 1-877. Zależność napięcia U_{CE} od prądu kolektora



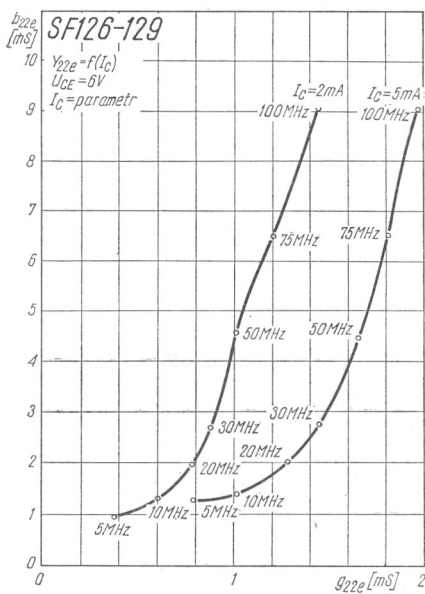
Rys. 1-878. Zależność prądu zerowego kolektora od temperatury złącza



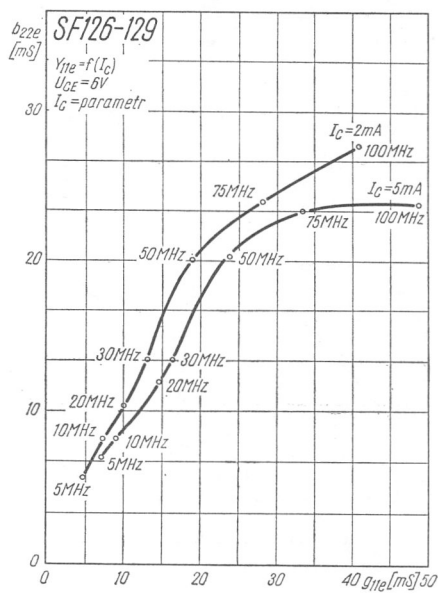
Rys. 1-879. Zależność współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu kolektora



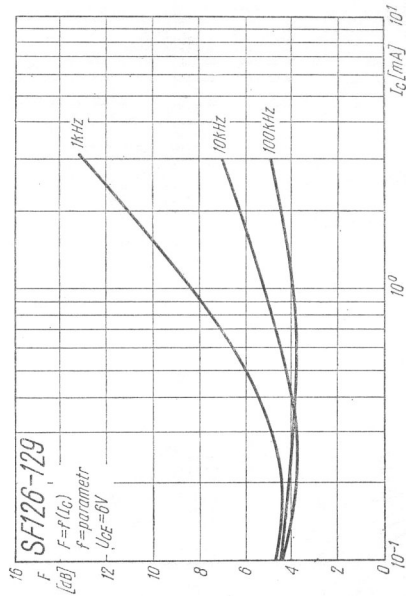
Rys. 1-880. Zależność współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu kolektora



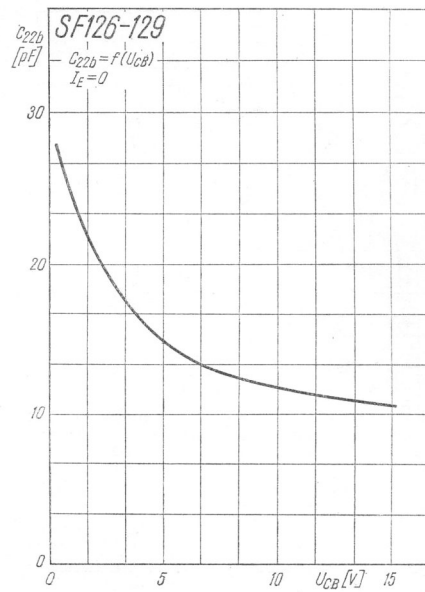
Rys. 1-881. Zależność admitancji wyjściowej w układzie OE



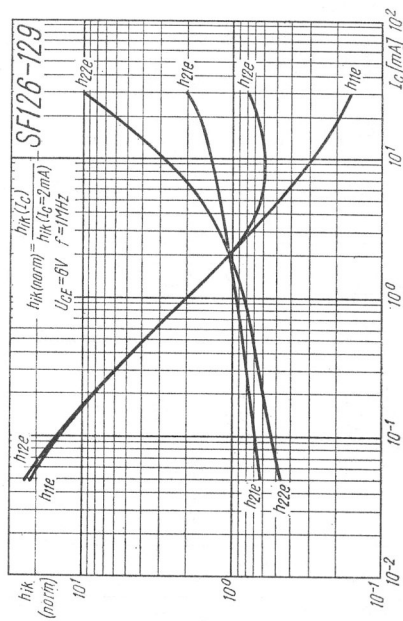
Rys. 1-882. Zależność admitancji wejściowej w układzie OE



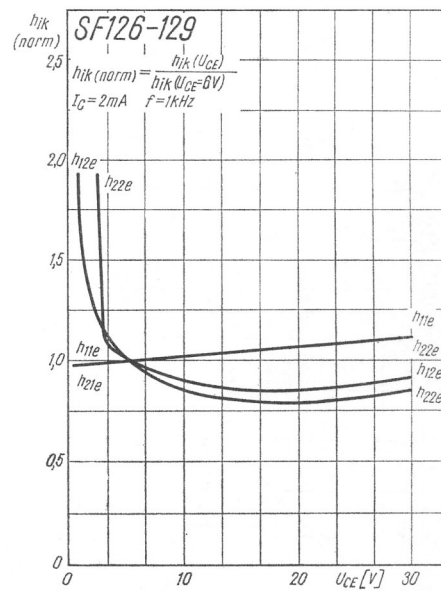
Rys. 1-883. Zależność współczynnika szumów od prądu kolektora



Rys. 1-884. Zależność napięciowa pojemności C_{22b}



Rys. 1-885. Zależność parametru h od prądu kolektora



Rys. 1-886. Zależność napięciowa parametru h